

2SC2267H

シリコン NPN 三重拡散形

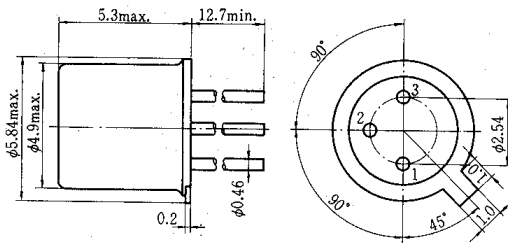
高電圧スイッチング用

2SA1024[Ⓜ] とコンプリメンタリペア

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

HIGH VOLTAGE SWITCHING

Complementary pair with 2SA1024[Ⓜ]



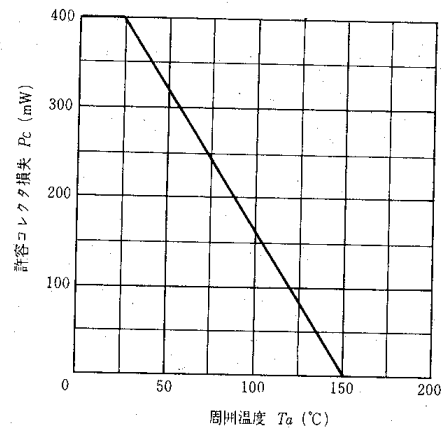
1. エミッタ: Emitter
 2. ベース: Base
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-18)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	2SC2267 [Ⓜ]	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	400	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	360	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	100	mA
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	500	mA
許容コレクタ損失	P_C	400	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	400	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	360	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CEO}	$V_{CE}=250\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	1.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=20\text{V}, I_C=20\text{mA}$	35	—	200	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$	—	0.2	1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(\text{sat})}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$	—	—	1.3	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}$	40	70	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	4.0	10	pF